Dispositif micromécanique comportant un élément suspendu rattaché à un support par un pilier et procédé de fabrication d'un tel dispositif

5 Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un dispositif micromécanique comportant au moins un élément suspendu rattaché à un support par un pilier comportant une base et un sommet.

10

15

20

État de la technique

Les systèmes micromécaniques, par exemple les capteurs d'accélération, comportent classiquement des éléments en suspension, mobiles ou fixes. Ces microsystèmes sont utilisés notamment dans des applications automobiles pour la correction de suspension, pour l'assistance à la conduite et pour l'ouverture des air-bags, nécessitant une mesure de l'accélération comprise entre 0 et 25g. Des capteurs d'accélération sont également utilisés dans des pace-makers, nécessitant une mesure de l'accélération comprise entre 0 et 2g.

25

Comme représenté à la figure 1, un élément suspendu 1 est classiquement fixé, par un pilier 2, à un support 3. Les procédés actuels de fixation de l'élément suspendu 1 au support 3 consistent à faire croître des couches minces sur le support 3, pour constituer le pilier 2 et l'élément suspendu 1. Ainsi, le pilier comporte respectivement une base 4 en contact avec le support 3 et un sommet 5 en contact avec l'élément suspendu 1. La tenue mécanique à la traction de l'élément suspendu 1 par rapport au support 3 est assurée par l'adhérence des matériaux aux interfaces, notamment à l'interface entre le matériau de l'élément

suspendu 1 et le matériau du pilier 2 au sommet 5 du pilier, d'une part, et à l'interface entre le matériau du support 3 et le matériau du pilier 2 à la base 4 du pilier, d'autre part. Ces procédés sont, par exemple, utilisés pour la croissance d'un pilier 2 en matériau électriquement isolant, par exemple en nitrure de silicium (SiN), sur un support 3 en silicium (Si). La tenue mécanique entre ces matériaux peut être insuffisante, notamment dans le cas où des surpressions sont appliquées dans les microsystèmes, par exemple dans le cas de systèmes où l'on souhaite amortir les vibrations de l'élément suspendu 1 ou dans des débitmètres.

10

15

20

25

5

Objet de l'invention

L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et, en particulier, d'augmenter la tenue mécanique des systèmes micromécaniques comportant un élément suspendu.

Selon l'invention, ce but est atteint par les revendications annexées et, plus particulièrement, par le fait que le support comporte une cavité gravée dans un substrat et débouchant à la surface du substrat faisant face à l'élément suspendu, la cavité ayant au moins une zone élargie dont la section est supérieure à la section de la cavité à ladite surface, la base du pilier, de forme complémentaire à la cavité, étant enterrée dans la cavité.

Description sommaire des dessins

5

10

15

20

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 représente un dispositif selon l'art antérieur.

Les figures 2 et 3 représentent des modes de réalisation particuliers du dispositif selon l'invention.

Les figures 4 à 12 représentent les étapes successives d'un mode de réalisation particulier du procédé selon l'invention, le matériau destiné à constituer le pilier étant déposé sur les parois de l'orifice sans remplir l'orifice.

Les figures 13 à 17 représentent les étapes successives d'un autre mode de réalisation particulier du procédé selon l'invention, le matériau destiné à constituer le pilier remplissant l'orifice.

La figure 18 représente un mode de réalisation particulier du dispositif selon l'invention, comportant un capot solidaire d'un pilier supplémentaire.

La figure 19 représente un autre mode de réalisation particulier du dispositif selon l'invention.

Description de modes particuliers de réalisation

Dans le dispositif micromécanique représenté à la figure 2, la base 4 du pilier 2 est enterrée dans une cavité 6, complémentaire, du support 3 et comporte, dans la cavité 6 du support 3, une zone de section élargie, formant, de préférence, un assemblage de type tête à clou ou à queue d'aronde avec la cavité 6 du support 3. Ainsi, l'ancrage du pilier 2 dans le support 3 est plus résistant que l'ancrage

classique par adhésion. Le matériau destiné à constituer le pilier 2 peut être un matériau conducteur, par exemple du silicium, ou un composé isolant de type SiN.

Sur la figure 3, le sommet 5 du pilier 2 est également enterré dans une première cavité 7, complémentaire, de l'élément suspendu 1. Le sommet 5 du pilier 2 comporte, dans la première cavité 7 de l'élément suspendu 1, une zone de section élargie, formant, par exemple, un assemblage de type tête à clou ou à queue d'aronde avec la première cavité 7 de l'élément suspendu 1. Ainsi, l'ancrage de l'élément suspendu 1 sur le support 3 présente également une bonne tenue mécanique.

5

10

15

20

25

Un procédé de réalisation du dispositif, illustré aux figures 4 à 12, comporte des étapes classiques, par exemple des dépôts et des gravures de couches minces, et des étapes de gravure particulières, générant par exemple des flancs de gravure obliques. Comme représenté à la figure 4, une couche sacrificielle 8, une couche solide 9 et une couche sacrificielle supplémentaire 10 sont successivement déposées sur une surface du support 3 qui est, de préférence, en silicium. L'épaisseur de la couche sacrificielle 8 détermine la distance finale entre le support 3 et l'élément suspendu 1. A titre d'exemple, les épaisseurs des couches sont respectivement de 2 µm pour la couche sacrificielle 8, de 320 nm pour la couche solide 9 et de 70 nm pour la couche sacrificielle supplémentaire 10. Les couches sacrificielles 8 et 10 sont, de préférence, en silice et la couche solide 9 en silicium. On peut, par exemple, réaliser l'empilement des couches à partir de substrats du type silicium sur isolant (« SOI : silicon on insulator »), ayant une couche de Si0₂ disposée entre une couche de silicium et un substrat en silicium.

Puis, un orifice 11 est gravé dans l'empilement constitué par la couche sacrificielle supplémentaire 10, la couche solide 9 et la couche sacrificielle 8 (figures 5 et 6). Comme représenté à la figure 5, la couche sacrificielle supplémentaire 10 peut être gravée en créant, dans la couche sacrificielle supplémentaire 10, des flancs de gravure obliques, de manière à ce que la partie supérieure de l'orifice 11 se rétrécisse vers le fond et forme, ainsi, une zone élargie dans la partie supérieure de la couche sacrificielle supplémentaire 10. La gravure de la couche sacrificielle supplémentaire 10 peut être faite par gravure humide, par exemple en utilisant des solutions à base d'acide fluorhydrique et un masque en résine, ou par gravure plasma sèche isotrope utilisant du SF₆.

5

10

15

20

25

Comme représenté à la figure 6, la couche solide 9 et la couche sacrificielle 8 peuvent être gravées de manière à créer des flancs de gravure sensiblement perpendiculaires aux couches 8 et 9. L'orifice 11 traverse alors la totalité de la couche sacrificielle 8, jusqu'à la surface du support 3, ce qui correspond, par exemple, à une profondeur de l'orifice de l'ordre de 3 µm.

Comme représenté sur la figure 7, le support 3 est ensuite gravé, dans le prolongement de l'orifice 11, de manière à former la cavité 6 du support 3 en forme de queue d'aronde. Ainsi, l'orifice s'élargit en profondeur. Une telle gravure peut notamment être réalisée par un procédé de gravure par plasma décrit dans le document US5501893. Ce procédé utilise deux étapes en alternance : une étape de passivation et une étape de gravure. L'étape de passivation consiste à déposer une couche protectrice de polymère (à base de C_4F_8) sur le support 3 à graver, notamment sur les flancs et le fond de gravure. L'étape de gravure utilise un plasma de SF_6 , qui permet de graver la couche de polymère et le support 3. Une tension électrique appliquée au support 3 permet d'accélérer les ions SF_6 en direction du support 3, ce qui amplifie la gravure

dans le fond, tandis que les flancs sont protégés par la couche protectrice de polymère. Ainsi, la cavité 6 gravée est plus large en profondeur qu'à la surface du support 3. Le réglage des paramètres de gravure et de passivation, notamment de la pression, du débit et du temps de cycle de gaz réactifs, par exemple de SF₆ et de C₄F₈, et de la tension appliquée au support en silicium, permettent d'obtenir des flancs gravés verticaux. Or, la cavité 6 gravée est plus large en profondeur qu'à la surface du support 3. Cette forme avec pente négative peut être obtenue en jouant sur plusieurs paramètres, par exemple, en augmentant les temps de gravure par rapport au temps de passivation ou en jouant sur les pressions et/ou la tension électrique appliquée au support 3.

5

10

15

20

25

Après gravure de la cavité 6 du support 3, un matériau 12, destiné à constituer le pilier 2, est déposé dans la cavité 6 du support 3 et au moins sur les parois de l'orifice 11 (figure 8). Sur la figure 8, le matériau 12, de préférence isolant électrique, par exemple du SiN, est également déposé sur la couche sacrificielle supplémentaire 10. Comme représenté à la figure 9, le matériau 12 déposé sur la couche sacrificielle supplémentaire 10 peut être éliminé par polissage ou gravure plasma.

La couche sacrificielle supplémentaire 10 est ensuite éliminée, par exemple par gravure humide, (figure 10) et un matériau 13, de préférence du Si, destiné à constituer l'élément suspendu 1, est déposé sur la couche solide 9 et le matériau 12, constituant le pilier 2, de manière à remplir l'orifice 11 (figure 11). La couche 9 sert également de support au matériau 13, notamment dans le cas où celui-ci est déposé par épitaxie. La couche 9 est ainsi intimement liée au matériau 13, et constitue avec celui-ci l'élément suspendu. Le matériau 13 peut ensuite être lissé par polissage ou gravure et la couche sacrificielle 8 est ensuite enlevée (figure 12).

Après gravure de la couche sacrificielle 8, l'élément suspendu est alors ancré sur le support 3 par le pilier 2. La solidité de l'ancrage ne dépend pas seulement de la qualité de l'adhérence intrinsèque des matériaux, mais elle est renforcée par l'assemblage avec une zone de section élargie et par exemple de type en queue d'aronde ou tête à clou.

5

10

15

20

25

Le mode de réalisation représenté aux figures 8 à 12 peut, par exemple, être utilisé pour réaliser un pilier 2 d'une dimension latérale externe supérieure à 2 µm et une couche de matériau 12 d'une épaisseur inférieure à 1µm. Ainsi, la couche de matériau 12 remplit la cavité 6 et recouvre les parois de l'orifice 11, comme représenté aux figures 8 à 12.

Dans un autre mode de réalisation, représenté aux figures 13 à 17, le matériau 12, destiné à constituer le pilier 2, peut remplir complètement l'orifice 11, ce qui est, par exemple, le cas lorsque la dimension latérale externe du pilier 2 est inférieure à la moitié de l'épaisseur de la couche du matériau 12 constituant le pilier 2.

Sur la figure 13, le matériau 12 isolant est déposé de manière à remplir l'orifice 11 et à recouvrir la couche sacrificielle supplémentaire 10. Après polissage du matériau 12 (figure 14) et élimination, par exemple par gravure, de la couche sacrificielle supplémentaire 10 (figure 15), le matériau 13, destiné à constituer l'élément suspendu 1, peut être déposé (figure 16) sur la couche solide 9 et sur le pilier 2, de manière à former un assemblage à queue d'aronde avec le sommet 5 du pilier 2. Ensuite, la couche sacrificielle 8 peut être enlevée (figure 17).

Dans le cas où on ajoute un capot 14 destiné à recouvrir l'ensemble des parties fixes et mobiles du dispositif, le capot 14 peut également être fixé à l'élément

suspendu 1 par l'intermédiaire d'un assemblage en queue d'aronde. Sur la figure 18, le dispositif comporte un capot 14 solidaire d'un pilier supplémentaire 15, perpendiculaire au capot 14. Une base 16 du pilier supplémentaire 15, opposée au capot 14, est enterrée dans une deuxième cavité 17, complémentaire, de l'élément suspendu 1. La base 16 du pilier supplémentaire 15 est élargie dans la deuxième cavité 17 de l'élément suspendu 1, formant, de préférence, un assemblage à queue d'aronde, avec la deuxième cavité 17 de l'élément suspendu 1.

5

10

15

20

25

L'assemblage à queue d'aronde ou en forme de tête à clou entre le pilier supplémentaire 15 et l'élément suspendu 1 peut être réalisé de manière analogue à l'assemblage entre le support 3 et le pilier 2. Ainsi, l'élément suspendu 1 est gravé, de manière à former la deuxième cavité 17 de l'élément suspendu 1 en forme de queue d'aronde ou en forme de tête à clou. Un matériau, destiné à constituer la base 16 du pilier supplémentaire 15, est ensuite déposé, au moins dans la deuxième cavité 17 de l'élément suspendu 1.

Dans un mode de réalisation particulier, le matériau constitutif de la base 16 du pilier supplémentaire 15 solidaire du capot 14 est un matériau isolant, par exemple du SiN, pour empêcher la conduction électrique entre le capot 14 et l'élément suspendu 1.

Dans un autre mode de réalisation, une couche 18 électriquement isolante, par exemple en SiN, peut être déposée à l'interface entre l'élément suspendu 1 et le pilier supplémentaire 15. Dans le cas ou une continuité électrique entre le capot 14 et l'élément suspendu 1 n'est pas gênante ou même souhaitée, la couche 18 n'est pas nécessaire.

Selon l'invention, la cavité 6 du support 3 est gravée dans un substrat et débouche à la surface du substrat faisant face à l'élément suspendu 1. Comme décrit précédemment, d'autres couches peuvent être déposées sur le substrat constituant le support. La cavité 6 a au moins une zone élargie dont la section est supérieure à la section de la cavité 6 à ladite surface. Dans le mode de réalisation décrit précédemment, cette zone élargie est formé de manière à ce que la base 4 du pilier 2 et la cavité 6 du support 3 constituent un assemblage à queue d'aronde.

5

10

15

20

25

Dans le mode de réalisation particulier représenté à la figure 19, deux zones élargies de la cavité 6 sont constituées par deux rainures 19 superposées. La base 4 du pilier 2 comporte au moins deux nervures 20 complémentaires audites rainures 19. Pour une cavité 6 d'un diamètre de l'ordre du micromètre, la hauteur d'une des rainures 19 selon un axe A perpendiculaire au support 3 est, de préférence, comprise entre 0,27 et 0,34 micromètres. La profondeur des rainures dans le plan du support 3 est, de préférence, comprise entre 0,1 et 0,3 micromètres. Le nombre de rainures 19 peut être supérieur à deux. Ainsi, on obtient une cavité 6 dont les flancs sont sensiblement perpendiculaire au support 3, le profil des flancs ayant une forme ondulée correspondant aux rainures 19. Dans un autre mode de réalisation, les flancs sont ondulés comme précédemment et inclinés par rapport au support 3 de manière à former une queue d'aronde.

Les rainures 19 peuvent être réalisées, de manière connue, par un procédé utilisant une étape de passivation et une étape de gravure en alternance, dans lequel le taux de C₄F₈ peut être diminué ou supprimé au cours de l'étape de gravure utilisant un plasma de SF₆. Pour former le pilier 2, la cavité 6 est, de préférence, remplit par du nitrure de silicium SiN. Le remplissage est complet et ne laisse pas d'espace vide entre le pilier 2 et le substrat. Le pilier 2 du dispositif

obtenu est solidement ancré et casse sous l'effet d'une force latérale exercée sur le pilier, sans que le pilier 2 ne sorte de la cavité 6.

Revendications

5

10

25

- 1. Dispositif micromécanique comportant au moins un élément suspendu (1) rattaché à un support (3) par un pilier (2) comportant une base (4) et un sommet (5), dispositif caractérisé en ce que le support (3) comporte une cavité (6) gravée dans un substrat et débouchant à la surface du substrat faisant face à l'élément suspendu (1), la cavité (6) ayant au moins une zone élargie dont la section est supérieure à la section de la cavité (6) à ladite surface, la base (4) du pilier (2), de forme complémentaire à la cavité (6), étant enterrée dans la cavité (6).
- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la base (4) du pilier
 et la cavité (6) du support (3) constituent un assemblage à queue d'aronde.
- 3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins deux zones élargies de la cavité (6) sont constituées par au moins deux rainures superposées, la base (4) du pilier (2) comportant au moins deux nervures complémentaires audites rainures.
- 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le sommet (5) du pilier (2) est enterré dans une première cavité (7), complémentaire, de l'élément suspendu (1), le sommet (5) du pilier (2) comportant, dans la première cavité (7) de l'élément suspendu (1), une zone de section élargie.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le sommet (5) du pilier (2) et la première cavité (7) de l'élément suspendu (1) constituent un assemblage à queue d'aronde.

- 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte un capot (14) solidaire d'un pilier supplémentaire (15), une base (16) du pilier supplémentaire (15), opposée au capot (14), étant enterrée dans une deuxième cavité (17), complémentaire, de l'élément suspendu (1), la base (16) du pilier supplémentaire (15) comportant, dans la deuxième cavité (17) de l'élément suspendu (1), une zone de section élargie.
- 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la base du pilier supplémentaire (15) et la deuxième cavité (17) de l'élément suspendu (1) constituent un assemblage à queue d'aronde.
- 8. Dispositif selon l'une des revendications 6 et 7, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement isolante (18) disposée à l'interface entre l'élément suspendu (1) et le pilier supplémentaire (15).

15

25

5

10

- 9. Procédé de fabrication d'un dispositif micromécanique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte :
- le dépôt, sur une surface du support (3), d'au moins une couche sacrificielle
 (8),
- la gravure, dans la couche sacrificielle (8), d'un orifice (11) traversant la couche sacrificielle (8) jusqu'à la surface du support (3),
 - la gravure du support (3), dans le prolongement de l'orifice (11), de manière à former la cavité (6) du support (3) en forme de queue d'aronde,
 - le dépôt dans la cavité (6) du support (3) et au moins sur les parois de l'orifice (11), d'un matériau destiné à constituer le pilier (2).
 - 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comporte :
 - avant gravure de l'orifice (11), le dépôt, sur la couche sacrificielle (8), d'une couche solide (9), et d'une couche sacrificielle supplémentaire (10),

- la gravure de l'orifice (11) étant réalisée dans l'empilement constitué par la couche sacrificielle supplémentaire (10), la couche solide (9) et la couche sacrificielle (8), l'orifice (11) comportant une zone élargie dans la couche sacrificielle supplémentaire (10),
- l'élimination, après dépôt du matériau (12) destiné à constituer le pilier (2),
 de la couche sacrificielle supplémentaire (10),
 - le dépôt, sur la couche solide (9) et le matériau (12) constituant le pilier (2),
 d'un matériau (13) constituant l'élément suspendu (1),
 - l'élimination de la couche sacrificielle (8).

10

15

20

- 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comporte :
- la gravure de l'élément suspendu (1), de manière à former une deuxième cavité (17), en forme de queue d'aronde, dans l'élément suspendu (1),
- le dépôt dans la deuxième cavité (17) de l'élément suspendu (1), d'un matériau destiné à constituer la base (16) d'un pilier supplémentaire (15) solidaire d'un capot (14).
- 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que le matériau (12) destiné à constituer le pilier (2) est déposé de manière à remplir l'orifice (11).

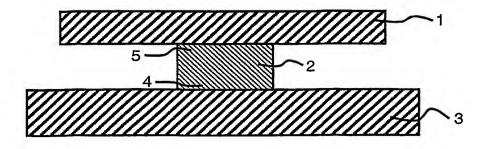


Figure 1 (Art antérieur)

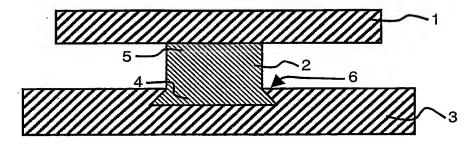


Figure 2

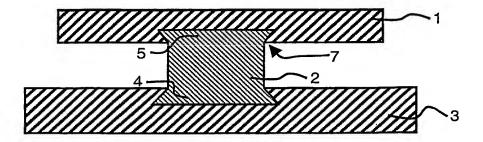
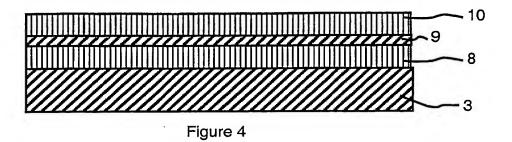
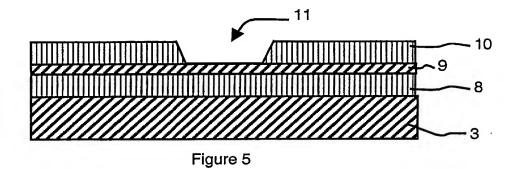
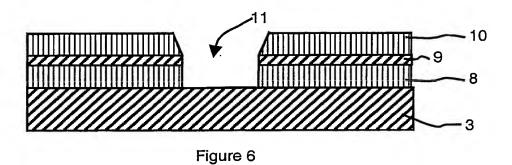
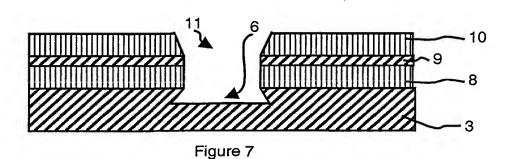


Figure 3









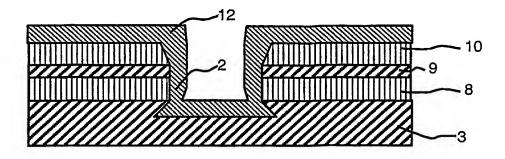


Figure 8

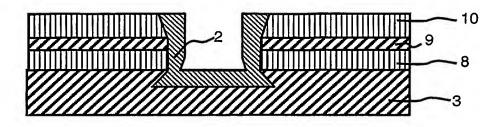


Figure 9

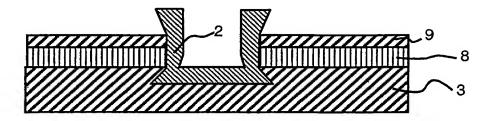


Figure 10

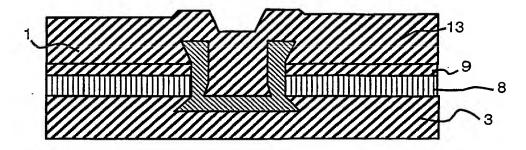


Figure 11

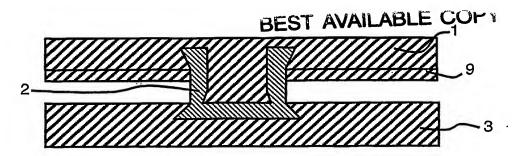


Figure 12

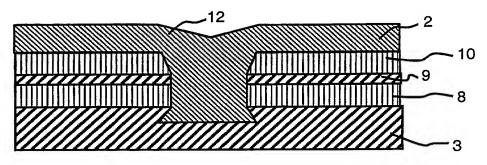


Figure 13

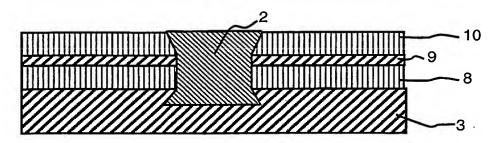


Figure 14

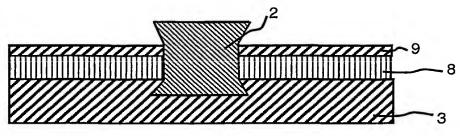


Figure 15

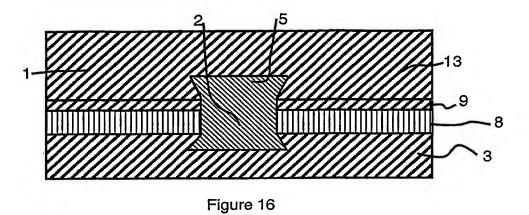


Figure 17

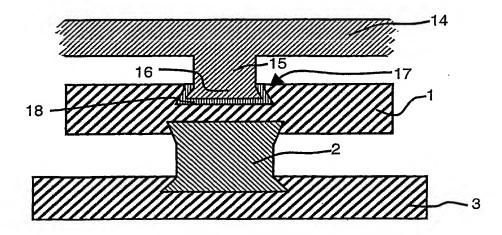


Figure 18

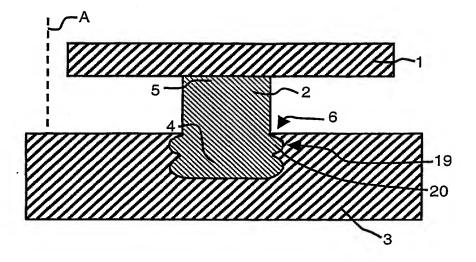


Figure 19

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No FR2004/002184

A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE B8183/00				
Selon la clas	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB			
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE				
Documentat CIB 7	ion minimale consultée (systeme de classification suivi des symboles d B81B	le dassement)			
Documentat	ion consultee autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche		
)	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n ternal, WPI Data, PAJ	om de la base de données, et si realisab	le, termes de recherche utilisés)		
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Calegorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication c	des passages pertinents	no des revendications visées		
X	US 5 334 342 A (HARKER ET AL) 2 août 1994 (1994-08-02) figures 6A-6L colonne 8, ligne 40 - ligne 59 colonne 9, ligne 3 - colonne 10, l	igne 3	1,2,9,12		
Α	WO 01/09579 A (XACTIX INC) 8 février 2001 (2001-02-08) figures 9A-9J		1,2,8,9		
A	US 2002/033453 A1 (AMANTEA ROBERT 21 mars 2002 (2002-03-21) figures 2,5	ET AL)	1,2		
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	evets sont indiques en annexe		
 Catégories spéciales de documents cités 'A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement perfinent 'E' document anténeur, mais publié à ta date de dépôt international ou après cette date 'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorite ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (tielle qu'indiquée) 'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou lous autres moyens 'P' document publie avant la date de depôt international, mais posterieurement à la date de priorité revendiquée 'T' document ultérieur publie après la date de dépôt international ou ta date de priorité rei appartieunent, nais cité pour comprendre le principe ou la théone constituant la base de l'invention 'X' document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée en peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré solément 'Y' document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activite inventive par rapport au document pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activite inventive par rapport au document, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activite inventive par rapport au document, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme impliquant une activite inventive par rapport au document, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveille ou comme nouveille ou comme ne proper sur l'appartie de l'au document et au date de depôt une autre de la même nature, cette combinaison étant evidente pour une per					
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du present rapport d	de recherche internationale		
	17 février 2005 25/02/2005				
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Fonctionnaire autorise			
	Fax (+31-70) 340-2040, 1x 31 651 epo ni,	McGinley, C			

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnements re

iux membres de familles de brevets

T/FR2004/002184

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5334342	Α	02-08-1994	US	5242711 A	07-09-1993
WO 0109579	Α	08-02-2001	AU	6613600 A	19-02-2001
			EP	1203208 A1	08-05-2002
			WO	0109579 A1	08-02-2001
			US	6566725 B1	20-05-2003
			US	2002086540 A1	04-07-2002
US 2002033453	A1	21-03-2002	US	6249001 B1	19-06-2001
			US	5985886 A	16-11-1999
			US	5844238 A	01-12-1998
			US	6127371 A	03-10-2000
			AU	2723997 A	17-10-1997
			EP	0892917 A1	27-01-1999
			WO.	9736155 A1	02-10-1997
			US	5965886 A	12-10-1999

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No T/FR2004/002184

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B81B3/00					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classificate $B81B$.	on symbols)			
• • •					
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields se	earched		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ				
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Ctation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No		
x	US 5 334 342 A (HARKER ET AL)		1,2,9,12		
"	2 August 1994 (1994-08-02)				
	figures 6A-6L column 8, line 40 - line 59				
	column 9, line 3 - column 10, lin	ne 3			
A	WO 01/09579 A (XACTIX INC)		1,2,8,9		
	8 February 2001 (2001-02-08)		-,-, ,		
	figures 9A-9J		1		
Α	US 2002/033453 A1 (AMANTEA ROBERT ET AL)		1,2		
	21 March 2002 (2002-03-21)				
	figures 2,5				
- Eur	ther documents are listed in the continuation of box C	χ Patent family members are listed	n annex		
<u> </u>		A I alone labelly thomselve are taken			
° Special categories of cited documents "T" tater document published after the international filing date or pnortly date and not in conflict with the application but					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance underlying the invention					
"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance, the claimed inventigating date cannot be considered novel or cannot be considered inventigations. The properties the considered inventigation of the properties are properties as properties as a propert					
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to mobile an inventive step when the					
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *C* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *C* document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent			family		
1	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report		
,	7 February 2005	25/02/2005			
		Authonzed officer			
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, PB 5818 Patentlaan 2	Authorized Offices			
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340–2040, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340–3016	McGinley, C			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

T/FR2004/002184

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5334342	02-08-1994	US 5242711 A	07-09-1993
WO 0109579	08-02-2001	AU 6613600 A EP 1203208 A1 WO 0109579 A1 US 6566725 B1 US 2002086540 A1	19-02-2001 08-05-2002 08-02-2001 20-05-2003 04-07-2002
US 2002033453	1 21-03-2002	US 6249001 B1 US 5985886 A US 5844238 A US 6127371 A AU 2723997 A EP 0892917 A1 WO 9736155 A1 US 5965886 A	19-06-2001 16-11-1999 01-12-1998 03-10-2000 17-10-1997 27-01-1999 02-10-1999